

دراسة خصائص أغشية Ag<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> الرقيقة المرسبة بطريقة التحلل الحراري الكيميائي

- من قبل ســاره محمود عبدالله (بکالوریوس علوم فیزیاء 2015)
  - بإشراف

أ. د. صباح أنور سلمان

أ. د. نبيل علي بكر

▲ 1442

2020 م

<u>ج</u>الله التَّحْمَز ٱلرِّحِيمِ

﴿ نَ وَٱلْقَلِمَ وَمَا يَسَطُرُونَ ٢ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ٢ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ٢ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق

عَظِيمٍ ٢

صدق الله العظيم

سورة القلم

Ita 1

إلى من بلغ الرسالة وأدى ألامانة. .ونصح الأمة. .ألى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه أجمعين.

إلى من كلله الله بالهيبة والوقار . . . إلى من علمني العطاء بدون أنتظار . . . إلى من أحمل أسمه بكل أفتخار . . . أرجو من الله أن يمد في عمرك لترى ثماراً قد حان قطفها بعد طول أنتظار . . . (والدي العزيز)

إلى من فرشت أيام عمرها لأيصالي . . . إلى معنى الحب . . . إلى معنى التفاني . . . إلى من أضاءت لي عمرها لتنير لي كل الأزمان . . . إلى من طوقتني بالحب لتمحي كلمة الحرمان . . . إلى من لولاها لما كنت هذا الأنسان . . . ( **أمي الحبيبة**) .

إلى . . . أصحاب القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة (**أخوتي وأختي**)

إلى . . . القلب النقي الذي يمدني بالأمان (**زوجي العزيز**)

إلى..... من أشعلتم لنا أصابِعكم لتنيروا لنـا الطـريق "**أساتذتي الأجلاء**". الى..... رفقاء الـدرب **زملائى وزميلاتى**.

((لكم جميعا أهدى ثمرة جهدي))

شکر وتآ دیس

كن عالماً فإن لم تستطع فكن متعلماً فإن لم تستطع فأحب العلماء فإن لم تستطع فلا تبغضهم.

بعد رحلة بجث وجهد تكللت بإنجاز هذا البحث ،نحمد الله عز وجل على نعمه التي من بها علينا فهو العلي القدير .والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخرين معلم البشرية سيدنا محمد القائل في حديثه (لايشكر الله من لايشكر الناس ) .

وعملا بهذا التوجيه النبوي أتوجه بالشكر الى اساتذتي الأفاضل الأستاذ الدكتور/**نبيل علي بكر و**الأستاذ الدكتور/**صباح أنور سلمان** لتفضلهما مشكورين بقبول الأشراف على هذه الرسالة ،فكان لما منحاني من علمهما وجهدهما وخبرتهما ووقتهما ،ولم يبخلو علي بأي عطاء وتوجيه فضلاً عن حرصهما الشديد لإخراج هذا البحث في أفضل صورة ممكنة، فأدعو الله العلي العظيم أن يبارك في عمرهما وعملهما .

كما اتقدم بجزيل الشكر الى عمادة كلية العلوم وعلى رأسهم عميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور/**تحسين حسين** مبارك

كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الأمتنان الى رئاسة القسم وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور/**زياد طارق خضير** رئيس قسم علوم الفيزياء على تعاونهم الشديد وأحتضانهم لي طول فتره الدراسة .

كما يطيب لي أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير الى جميع اساتذتي الأفاضل. . . .

وأتوجه بشكري الى كادر مكتبة كلية العلوم جميعا . . . . .

كما وأقدم شكري الى من كان عوناً لي في مجثي للزميل (محمد علي عبد) والأخوات (ميس أديب و هبة جعفر) والى طلبة الدراسات العليا كافة. . . وفي الختام أقدم شكري وتقديري الى كل من فاتني ذكرهم. . .

# البحوث المنشورة

 S. M. Abdullah, N, A, Bakr, S. A. Salman "Structural, Optical, and electrical properties of Ag<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> sprayed thin films by chemical pyrolysis method", Chalcogenide Letters, Vol. 18, No. 2, pp. (65-73), (2021).



تم تحضير أُغشية Ag<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> الرقيقة وذلك بترسيبها على قواعد زجاجية .بدرجة حرارة (C<sup>°</sup> C) و بسمك (Ano 10 mm) و بأختلاف تركيز الثايوريا و بأستخدام طريقة التحلل الحراري الكيميائي. تم دراسة الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية للأغشية المحضرة كافة بأستخدام تقنية حيود الأَشعة السينية (XRD) و مطياف رامان (FESEM) و المجهر الألكتروني الماسح الباعث للمجال (FESEM) و مطياف الأَشعة فوق البنفسجية-المرئية ((UV-Visible spectrophotometer(300-900)) ((UV-Visible spectrophotometer(300).

Ag<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> (AZTS) بينت نتائج حيود الأشعة السينية (XRD) أن جميع أغشية (Pirquitasite) ومن طور الرقيقة ذات تركيب بلوري رباعي (Tetragonal) من نوع (Pirquitasite) ومن طور (Stannite) مع اتجاه سائد (112). وتم تأكيد نتائج حيود الأشعة السينية (XRD) بأستخدام مطياف رامان لأغشية AZTS الرقيقة والذي أثبت نقاء الطور، حيث بينت النتائج ظهور القمة الاساس ذات اعلى شدة للمركب AZTS عند المواقع (<sup>1-</sup> 348 cm) مع ظهور قمم ثانوية ذات شدة أقل. بينت نتائج التركيب المورفولوجي من خلال صور (FESEM) قمم ثانوية ذات شدة أقل. بينت نتائج التركيب المورفولوجي من خلال صور (FESEM) على السطوح أغشية AZTS الرقيقة تكون غير منتظمة مع وجود بعض الشقوق والفراغات على السطوح، وتكون بأشكال كروية او شبة كروية. بينت الفحوصات البصرية من خلال طيف الأشعة الفوق البنفسجة-المرئية لأغشية AZTS الرقيقة أن لها فجوة طاقة بصرية للأنتقال الألكتروني المباشر المسموح تتراوح بين (Vec-2.080) ولها معامل محادية من خلال تأثير هول

قائمة المحتويات		
الصفحة	المحتوى	الفقرة
Ι	قائمة المحتويات	
V	قائمة الاشكال	
VII	قائمة الجداول	
VIII	قائمة الرموز	
X	قائمة المختصرات	
17 -1	مقدمة عامة	الفصل الاول
1	المقدمة	1-1
1	الأغشية الرقيقة	2-1
2	تطبيقات الأغشية الرقيقة	3-1
2	طرائق تحضير الاغشية الرقيقة	4-1
4	طريقة التحلل الحراري الكيميائي	5-1
5	الية تكوين الاغشية الرقيقة	6-1
6	تأثير حجم القطرة	7-1
8	الخصائص التركيبية لغشاء (AZTS)	8-1
9	الدر اسات السابقة	9-1
17	الهدف من البحث	10-1
40-18	الجزء النظري	الفصل الثاني
18	المقدمة	1-2
18	أشباه الموصلات	2-2
19	التركيب البلوري لأشباه الموصلات	3-2
19	أشباه الموصلات البلورية	1-3-2
19	أشباه الموصلات احادية التبلور	1-1-3-2

20	أشباه الموصلات متعددة التبلور	2-1-3-2
20	أشباه الموصلات غير البلورية	2-3-2
21	مركبات اشباه الموصلات	4-2
21	المركبات الرباعية	1-4-2
22	نظرية حزم الطاقة في اشباه الموصلات البلورية	5-2
23	الخصائص التركيبية	6-2
23	حيود الاشعة السينية	1-6-2
25	قانون براك	2-6-2
26	المعلمات التركيبية	3-6-2
26	ثوابت الشبيكة	1-3-6-2
26	حجم البلوريات	2-3-6-2
26	عامل التشكيل	3-3-6-2
27	كثافة الانخلاعات وعدد البلوريات	4-3-6-2
27	مطياف رامان	4-6-2
29	الخصائص البصرية	7-2
30	تفاعل الضوء مع شبه الموصل	1-7-2
30	حافة الامتصاص الاساسية	2-7-2
31	منطقة الامتصاص العالي	1-2-7-2
31	منطقة الامتصاص الاسي	2-2-7-2
32	منطقة الامتصاص الواطئ	3-2-7-2
32	النفاذية	3-7-2
33	الآمتصاصية	4-7-2
33	الإنعكاسية	5-7-2
34	الأنتقالات الالكترونية	6-7-2

34	الأنتقالات المباشرة	1-6-7-2
34	الآنتقالات غير المباشرة	2-6-7-2
36	الثوابت البصرية	7-7-2
36	معامل الامتصاص	1-7-7-2
37	معامل الانكسار	2-7-7-2
37	معامل الخمود	3-7-7-2
38	ثابت العزل البصري	4-7-7-2
39	الخصائص الكهربائية	8-2
39	تأثير هول	1-8-2
56-41	الجزء العملي	الفصل الثالث
41	مقدمة	1-3
42	منظومة التحلل الكيميائي الحراري	2-3
45	تحضير الأغشية الرقيقة	3-3
49	العوامل المؤثرة في تحضير الأغشية الرقيقة	4-3
50	ترسيب الأغشية الرقيقة	5-3
51	قياس سمك الأغشية الرقيقة	6-3
52	القياسات التركيبية	7-3
52	قياس حيود الأشعة السينية	1-7-3
52	قياسات مطياف رامان	2-7-3
53	قياسات المجهر الألكتروني الماسح الباعث للمجال	3-7-3
54	القياسات البصرية	8-3
55	القياسات الكهربائية	9-3
76-57	النتائج والمناقشة	الفصل الرابع
57	المقدمة	1-4

57	الخصائص التركيبية	2-4
57	فحوصات حيود الاشعة السينية	1-2-4
60	ثوابت الشبيكة	1-1-2-4
61	حجم البلوريات	2-1-2-4
62	عامل التشكيل	3-1-2-4
63	كثافة الانخلاعات وعدد البلورات لوحدة المساحة	4-1-2-4
64	فحوصات مطياف رامان	2-2-4
67	فحوصات المجهر الالكتروني الماسح الباعث للمجال	3-2-4
67	فحوصات مقياس طيف تشتت الطاقات	4-2-4
69	الخصائص البصرية	3-4
69	الأمتصاصية	1-3-4
69	معامل الأمتصاص	2-3-4
70	فجوة الطاقة	3-3-4
72	معامل الانكسار	4-3-4
72	معامل الخمود	5-3-4
73	ثابت العزل البصري	6-3-4
74	الخصائص الكهربائية	4-4
76	الآستنتاجات	5-4
76	المشاريع المستقبلية	6-4
84 -77	المصادر	

	قائمة الاشكال	
الصفحة	عنوان الشكل	الرقم
3	مخطط توضيحي لبعض تقنيات تحضير الاغشية الرقيقة	1-1
6	المراحل الاساسية لتكوين الاغشية الرقيقة	2-1
7	حالات الترسيب المختلفة اعتمادا على حجم القطرات المتكونة	3-1
8	وحدة البناء البلوري لمركب (AZTS)	4-1
9	التركيب البلوري لمركب (AZTS)	5-1
19	مخطط حزم الطاقة في المواد	1-2
20	التركيب البلوري للمواد	2-2
22	مخطط الطور للنظام شبه رباعي ( $Cu_2S$ - $ZnS$ - $SnS_2$ )	3-2
23	انشطار حزم الطاقة الى حزم طاقة مسموحة وممنوعة	4-2
24	التشخيص بالأشعة السينية	5-2
24	أنماط حيود الأشعة السينية (XRD)	6-2
25	المستويات البلورية وقانون براك	7-2
29	مخطط انتقالات الطاقة في مطياف رامان	8-2
32	مناطق الامتصاص	9-2
36	أنواع الانتقالات الالكترونية	10-2
40	ظاهرة تأثير هول	11-2
41	الخطوات المتبعة في الجزء العملي	1-3
42	منظومة التحلل الحراري الكيميائي المستخدمة في العمل	2-3
43	مخطط توضيحي جهاز الرش	3-3
45	صورة لمقياس تدفق الهواء	4-3
53	مخطط يوضح أجزاء مطياف رامان	5-3

54	مخطط المجهر الالكتروني الماسح الباعث للمجال	6-3
55	مخطط أجزاء جهاز المطياف الضوئي	7-3
56	a. مواقع ترسيب الاقطاب على العينات b. قاعدة النماذج	8-3
58	بطاقة (ICDD) لمادة AZTS المرقمة (ICDD)	1-4
59	انماط حيود الاشعة السينية لأغشية (AZTS)	2-4
62	حجم البلوريات لأغشية (AZTS) الرقيقة	3-4
63	كثافة الأنخلاعات لأغشية AZTS الرقيقة	4-4
63	عدد البلوريات لوحدة المساحة لأغشية AZTS الرقيقة	5-4
66	مخطط طيف رامان لأغشية (AZTS) الرقيقة	6-4
68	صور FE-SEM للنماذج (AZTS(1, 2, 3)	7-4
69	طيف الأمتصاصية لأغشية (AZTS) الرقيقة	8-4
70	معامل الأمتصاص لأغشية (AZTS) الرقيقة	9-4
71	فجوة الطاقة البصرية لأغشية (AZTS) الرقيقة	10-4
72	معامل الانكسار كدالة لطاقة الفوتون لأغشية (AZTS)	11-4
73	معامل الخمود كدالة لطاقة الفوتون لأغشية (AZTS)	12-4
73	الجزء الحقيقي لثابت العزل البصري لأغشية (AZTS) الرقيقة.	13-4
74	الجزء الخيالي لثابت العزل البصري لأغشية (AZTS) الرقيقة.	14-4
75	العلاقة بين تركيز الثايوريا وتوصيلية هول للأغشية (AZTS) الرقيقة.	15-4
75	العلاقة بين حاملات الشحنة وتحركيتها معتركيز الثايوريا لأغشية (AZTS)	16-4

قائمة الجداول		
الصفحة	عنوان الجدول	الرقم
46	خصائص المواد الأولية المستعملة في تحضير محلول	1-3
	الرش.	
48	تراكيز المحاليل المستخدمة ورموز العينات.	2-3
60	قمم الزوايا والمسافة البينية ومعاملات ميلر لأغشية	1-4
	(AZTS)الرقيقة	
61	قيم ثوابت الشبيكة وحجم وحدة الخلية القياسية لمركب	2-4
	AZTS	
61	قيم ثوابت الشبيكة وحجم وحدة الخلية لأغشية AZTS	3-4
	الرقيقة	
64	قيم المعلمات التركيبية لأغشية AZTS الرقيقة عند الاتجاه	4-4
	السائد (112)	
65	نتائج فحوصات مطياف رامان لأغشية AZTS الرقيقة	5-4
67	معدل الحجم الحبيبي المحسوب من خلال صور	6-4
	(FESEM) لأغشية AZTS الرقيقة	
68	قيم النسب الوزنية والذرية لفحص (EDS) لمكونات	7-4
	$Ag_2ZnSnS_4$ مركب	
75	نتائج قياس تأثير هول لأغشية (AZTS) الرقيقة	8-4

قائمة الرموز		
الوحدة	المعنى	الرمز
	عدد صحيح يمثل مرتبة الحيود	n
nm	الطول الموجي للأشعة الساقطة	λ
Å	المسافة بين المستويات البلورية	d <sub>hkl</sub>
degree	زاوية حيود براك	θ
Å	ثوابت الشبيكة	a∘ , c∘
nm	الحجم البلوري	D
Radian	عرض منحني منتصف القمة (FWHM)	β
	عامل التشكيل	T <sub>C</sub>
eV/m <sup>2</sup> .s	الشدة للشعاع النافذ	Ι
eV/m <sup>2</sup> .s	الشدة للشعاع الساقط	Į٥
cm <sup>-2</sup>	كثافة الأنخلاعات	δ
cm <sup>-2</sup>	عدد البلوريات لوحدة المساحة	N∘
cm <sup>-1</sup>	معامل الأمتصاص	α
eV	فجوة الطاقة البصرية	$\mathbf{E}_{\mathbf{g}}$
eV	طاقة الفوتون	hu
	ثابت يعتمد على طبيعة المادة	р
	معامل اسي يحدد نوع الانتقال	r
cm <sup>-1</sup>	ثابت تناسب	œ٥
meV	طاقة اورباخ	$\mathbf{E}_{\mathbf{u}}$
eV/m <sup>2</sup> .s	شدة الشعاع الممتص	I <sub>A</sub>
	معامل الخمود	K∘
	الآمتصاصية	Α

	النفاذية	Т
	الأنعكاسية	R
	معاملات میلر	hkl
	معامل الانكسار الحقيقي	n∘
	ثابت يعتمد على طبيعة المادة	B∘
cm <sup>-1</sup>	متجه الموجة	k
eV	طاقة الفونون	E <sub>ph</sub>
	معامل الإنكسار المعقد	Ν
	ثابت العزل المعقد	3
	الجزء الحقيقي لثابت العزل	ε <sub>1</sub>
	الجزء الخيالي لثابت العزل	ε <sub>2</sub>
V	فولتية هول	$V_{\rm H}$
W/m <sup>2</sup>	شدة المجال المغناطيسي	Bz
Mol/L	التركيز المولاري	М
g/mol	الوزن الجزيئي	M <sub>wt</sub>
nm	السمك	t
g/cm <sup>3</sup>	كثافة مادة الغشاء	ρ
cm <sup>3</sup> /c	معامل هول	R <sub>H</sub>
cm <sup>2</sup> /v.s	تحركية هول	$\mu_{\mathrm{H}}$
cm <sup>-3</sup>	تركيز حاملات الشحنة	n <sub>H</sub>

قائمة المختصرات	
Silver Zinc Tin Sulfide	AZTS
Copper Zinc Tin Sulfide	CZTS
Chemical Spray pyrolysis	CSP
R.F. Magnetron Sputtering	R.F.M.S
Chimical Bath Deposition	CBD
Simple Electron Deposition	SED
Soda Lime Glass	SLG
Hot-Injection	HI
P-N Junction	PN
Full Width at Half Maximum	FWHM
Scanning Electron Microscopy	SEM
Field Emission Scanning Electron Microscopy	FE-SEM
International Center for Diffraction Data	ICDD
X-Ray Diffraction	XRD
Valence Band	$V_{B}$
Conduction Band	CB



الفصل الاول

مقدمةعامية



#### Introduction

(1-1) المقدمة

تركزت في الوقت الحالي جهود الباحثين نحو تحضير مواد جديدة يتم من خلالها انتاج الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وذلك من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة الدائمة و والنظيفة من الخلايا الشمسية [1].

تعد فيزياء الأغشية الرقيقة من الفروع المهمة في فيزياء الحالة الصلبة، وذلك لاهتمامها بدراسة المواد شبه الموصلة، أذ اسهمت اسهاماً كبيراً في تطور العلوم. وقد حظيت المواد شبه الموصلة باهتمام كبير من قبل الباحثين، وذلك لما لهذه المواد من خصائص فيزيائية استثنائية، أذ تمتلك خواص العوازل عند درجة الحرارة المنخفضة (الصفر المطلق) ولها القابلية على التوصيل الكهربائي عندما ترتفع درجة حرارتها الى حد معين، أذ اصبح اعتماد الاجهزة الالكترونية على هذه المواد [2].

و توجهت حديثا تقنية استعمال الاغشية الرقيقة لأنتاج الخلايا الشمسية وذلك من خلال رفع القدرة الكهربائية وبكلفة رخيصة أذ تم صنع وتوفير الخلايا الشمسية من السليكون غير البلوري عام (1980) أذ يصل ادائها داخل المختبر الى اداء خلايا مصنوعة من نوعية جيدة من السليكون البلوري وتستمر الدراسات من اجل الحصول على مثل هذا الاداء خارج المختبر في المحطات الفضائية [3].

# (2-1) الاغشية الرقيقة

يستعمل مصطلح الأغشية الرقيقة (Thin Films) لوصف طبقة او عدة طبقات من ذرات مادة لا يتعدى سمكها ميكرون واحد او عدة اجزاء من النانومتر، إذ أن الأغشية الرقيقة تتكون من المادة الصلبة عند تحضيرها وترسيبها على شكل طبقات على أساس صلب بإحدى الطرق الكيميائية او الفيزيائية أو التفاعلات الكيميائية [4].

وللأغشية الرقيقة خواص ومميزات قد لا تكون موجودة في أنواع المواد الأخرى، وذلك بسبب قلة سمكها الذي يمتلك تركيبا" بلوريا" نادرا" يقترب من صفات التركيب أحادي التبلور ويتفوق عليه أحيانا"، أذ إن الأغشية الرقيقة للمادة يختلف تركيبها البلوري عن تركيب المادة عندما تكون بشكلها الاعتيادي بعدة نقاط منها [5]:-

1- يكون حجم البلوريات في الأغشية الرقيقة اصغر من حجمها الطبيعي في المادة.

## Thin Films

2- تكون العيوب النقطية للأغشية الرقيقة أكثر من بلورات المادة في وضعها الطبيعية خاصة عند درجات حرارة أعلى من (T = 0k) بسبب الحركة الاهتزازية لذرات المادة في مواقعها محدثة عيوب نقطية.

3- تحتوي الأغشية الرقيقة على نسبة شوائب أعلى بكثير مما هو عليه في المادة بشكلها الطبيعي الناتجة من طريقة التحضير.

# (3-1) تطبيقات الاغشية الرقيقة Applications of Thin Films

حظيت الأغشية الرقيقة بعناية كبيرة، وذلك لاستعمالاتها الواسعة ضمن عدة مجالات إذ تستعمل في عدد كبير من المجالات البصرية كتصنيع المرايا والألواح الزجاجية الحساسة للموجات الكهرومغناطيسية وتدخل في صناعة مرشحات التداخل والكواشف (Detectors) [6].

وكان للأغشية الرقيقة اسهام كبير في تطور مجال الحاسبات الالكترونية الرقمية وذلك لصغر حجمها وخفة وزنها إذ تم استعمالها في دوائر الفتح والغلق والدوائر المتكاملة (Integrated Circuits) وفي صناعة الترانزستورات وفي اجهزة الاستنساخ والخلايا الشمسية (Solar Cells) وغيرها من التطبيقات [7].

# (4-1) طرائق تحضير الاغشية الرقيقة

#### **Thin Films Preparation Methods**

إن الأستعمالات الواسعة للأغشية الرقيقة قد دفعت الباحثين الى استحداث طرائق عديدة ومختلفة لتصنيعها، ونتيجة للتطور العلمي فقد تطورت طرائق التحضير وبهذا اصبحت على درجة عالية من الدقة في تحديد سمك الغشاء وتجانسه وبهذا اصبحت لكل طريقة من هذه الطرائق خصائص ومميزات لتؤدي الغاية التي استعملت من اجلها. وان استعمال أي طريقة يعتمد على عوامل عديدة منها كلفة التحضير والمجال المستعمل فيه الاغشية المحضرة والمادة المستعملة في تصنيع الغشاء ومجال الاستعمال، وذلك لأن بعض هذه الطرائق مناسبة لمواد معينة وغير مناسبة لأخرى وقد يكون منها سهل الاستعمال ومنها يكون معقداً [8]. أما بصورة عامة فتقسم تقنيات تحضير الأغشية الرقيقة إلى عدة انواع منها تقنيات فيزيائية ومنها نقنيات كيميائية و كما هي موضحة في الشكل (1-1) [9].



الشكل (1-1): مخطط توضيحي لبعض تقنيات تحضير الاغشية الرقيقة [9].

(1-5) طريقة التحلل الحراري الكيميائي

#### **Chemical Pyrolysis Method**

تعد طريقة التحلل الكيميائي الحراري من الطرائق الشائعة إذ تم في هذا البحث تحضير الاغشية الرقيقة عن طريقها وذلك لسهولتها إذ تُحضر الاغشية عن طريق رش محلول المادة المطلوب تحضير الغشاء الرقيق منها على قواعد ساخنة من الزجاج أو الكوارتز وبدرجة حرارة ملائمة تعتمد على نوع المادة المستعملة ونتيجة للتفاعل الكيميائي الحراري بين ذرات المادة على سطح القاعدة بمساعدة درجة الحرارة نحصل على الاغشية، وهناك العديد من المادة على المتعرات و المؤرات التي يجب السيطرة عليها ويمكننا الحصول على افضل غشاء كمعدل المادة المرابق و الموات و الموات و المادة المرابق من الزجاج أو الكوارتز وبدرجة المالوب تحضير الغشاء الرقيق منها على قواعد ساخنة من الزجاج أو الكوارتز وبدرجة حرارة ملائمة تعتمد على نوع المادة المستعملة ونتيجة للتفاعل الكيميائي الحراري بين ذرات المادة على المادة المستعملة و الموارة نحصل على الاغشية، و هناك العديد من المادة على المادة المالة المالة عليها و يمكننا الحصول على افضل غشاء كمعدل جريان الهواء ونظافة القواعد الزجاجية [8].

إن هذه الطريقة ذات محاسن ايجابية تميز ها عن الطرق الاخرى وهي [8]:

1- تتكون منظومة الترسيب بالتحلل الكيميائي الحراري من عدة اجهزة بسيطة إذ إن كل اجهزتها المستعملة لا تحتاج الى اجهزة تفريغ او منظومات معقدة أي أنها اقتصادية إذ يتم الافادة منها فى تحضير اغشية رقيقة.

2- تعد هذه الطريقة الأفضل لتحضير أغشية ذات انعكاسية قليلة للأستخدام في الخلايا الشمسية من تقنية التبخير في الفراغ.

3- تعد طريقة جيدة في تحضير اغشية لمركبات ذات درجات انصهار عالية يصعب تحضيرها بالطرق الاخرى.

4- تستعمل في ترسيب الأغشية على مساحات واسعة إذ يمكن التحكم في عوامل الترسيب بسهولة للحصول على اغشية بمواصفات جيدة كالصفات البصرية والكهربائية والتركيبية من خلال مزج مادتين او اكثر او تغير تراكيز العناصر المستعملة في تحضير الغشاء.

5- من مميزات الاغشية المحضرة قوة التصاقها مع القاعدة عند توفر الظروف الملائمة لها.

1- لا تتكون الاغشية فيها بسهولة فقد تتكون بقع على القاعدة أو يتشوه الغشاء إذ تتطلب وقتاً طويلا وجهداً كبيراً للحصول على أغشية جيدة و متجانسة. 2- تستعمل فقط مع المحاليل الكيميائية، أي المواد القابلة للذوبان في الماء المقطر او المذيبات. (1-6) **آلية تكون الأغشية الرقيقة** 

#### **Mechanism of Thin Films Formation**

من الصفات المميزة للبنية التركيبية في الأغشية الرقيقة أنها تتسم بدرجة كبيرة من التعقيد مقارنة مع المواد الكتلية سواء كانت متعددة التبلور أو احادية التبلور، وذلك لأن الاغشية بشكل عام هي ذات تراكيب تكون فيها الحجوم الحبيبية صغيرة جدا" وبالتالي سوف تمتلك مناطق عدم انتظام وكثافة عيوب اكبر بكثير عند مقارنتها بالمواد الاخرى، إن عملية التحلل الكيميائي الحراري تضيف عوامل أخرى تؤثر في البنية التركيبية وبداية نمو الغشاء للأغشية المحضرة منها مثلاً قطر فتحة جهاز الترذيذ وحجم القطرة وكثافة توزيع القطرات على وحدة المساحة وعلية يكون تأثير هذه العوامل تأثيرا مباشرا في البنية التركيبية وتزيع القطرات على وحدة المساحة على الخصائص البصرية والكهربائية [8].

إذ أن الخطوات الأساسية لعملية أنماء الأغشية الرقيقة تكون كالأتي:

- تحضير مادة المحلول عن طريق أنتاج الذرات او الجزيئات لمحلول مادة الغشاء، ثم نقلها الى القواعد الساخنة عن طريق وسط ناقل كالهواء
  - 2. رشها على القواعد المهيأة لتحضير الغشاء.

تمر عملية نمو الأغشية الرقيقة بعدة مراحل اساسية تبدأ بالمرحلة الأولى مرحلة التنويه أي تكوين النويات التي تعد الأساس التي يبنى الغشاء الرقيق عليها والتي تتكون من أنتقال الأيونات او الذرات او الجزيئات من مصدر ها الى قاعدة الترسيب إذ تتصف النويات الملتصقة بالقاعدة بصغر حجمها، ثم تبدأ مرحلة نمو النويات التي يكون نموها بالأبعاد الثلاثة وبمحاذاة القاعدة أي يكون النمو أفقيا أكثر من كونه عموديا بسبب عملية الأنتشار السطحي للذرات إذ تكون هذه الصفة المميزة لنمو الأغشية الرقيقة [8، 10].

بعد ذلك تتصل النويات الواحدة بالأخرى بعد النمو مكونة جزر، وهناك عوامل عديدة لها تأثير على تكوين الجزر منها (درجة حرارة قاعدة الترسيب و معدل الترسيب على سطحها وتوافر مواقع التنويه على سطح القاعدة)، ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة تكون الحدود الحبيبية الثابتة بسبب التحام الجزر مع بعضها لتكوين بلورة أحادية التبلور إذا كانت الأتجاهات البلورية للجزر الملتحمة باتجاه واحد و بأستمرار الجزر الملتحمة بالألتحام مع بعضها البعض يبدأ شكلها بالتغيير إذ تستطيل وتمتد مرتبطة مع بعضها البعض مكونة مناطق ضيقة بالقرب من منطقة الالتصاق مع بعضها، تتصف هذه المناطق بكونها طويلة وغير منتظمة تعرف بالقنوات، وبالاستمرار بعملية الترسيب تنتج جزر ونوى وقنوات وتندمج سريعا عند ملامستها جدران القنوات مكونة الجسور تاركة تجاويف داخل الغشاء، تتلاشى هذه القنوات في النهاية وتختفي مكونة الغشاء المستمر من خلال استمرار تكوين الجزر الثانوية التي تلامس حافات الفجوات وتندمج مع الغشاء الرئيس [11]. والشكل (1-3) يبين المراحل الاساسية لتكوين الاغشية الرقيقة [21].



الشكل (1-3) يبين المراحل الاساسية لتكوين الاغشية الرقيقة [12].

#### **The Drops Size Effect**

(1-7) تأثير حجم القطرة

إن عملية تكوين الاغشية الرقيقة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري تعتمد على مبدأ اصطدام القطرات بالقاعدة إذ تنطلق القطرات مغادرة جهاز الرش بسرعة ابتدائية يحددها جهاز متجه نحو القاعدة الساخنة ويكون انطلاق القطرات بشكل رذاذ بهدف وصول اكبر عدد ممكن من القطرات للسطح ولابد من السيطرة على كفاءة ترذيذ القطرات للحصول على حجم القطرات المطلوب. وبذلك توجد اربع مراحل محتملة للتحلل اعتماداً على حجم القطرات المتكونة [13] والشكل (1-4) يُبيَّن حالات الترسيب المختلفة اعتمادا" على حجم القطرات المتكونة [14].



الشكل (1-4): حالات الترسيب المختلفة اعتمادا على حجم القطرات المتكونة [14].

1- الحالة A: في هذه الحالة تكون حجم القطرة كبيرة وبذلك تكون الحرارة الممتصة غير كافية لتبخير المحلول اذ عندما تصطدم القطرة بالقاعدة يتكون راسب صلب بعد تبخير المذيب وبذلك فإن كبر حجم القطرة يؤثر تأثيرا مباشرا على درجة حرارة القاعدة مما يؤدي الى انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير ومفاجئ ويؤدي الى احتمالية كسر القاعدة وذلك بسبب حصول اجهادات داخلية تؤثر بصورة مباشرة في خصائص الاغشية المحضرة.

2- الحالة B: تمثل الحالة الامثل لتكوين الغشاء الرقيق اذيتم الحصول فيها على خصائص الغشاء المطلوب، في هذه المرحلة تكون درجة حرارة القاعدة بين المتوسطة الى العالية إذ يكون فيها حجم القطرة بين المتوسطة الى الصغيرة وفيها يتبخر المذيب قبل الوصول الى القاعدة بقليل إذ تخضع الرواسب المتبخرة لتفاعل كيميائي عند اقرب نقطة الى سطح القاعدة.

3- الحالة C: في هذه الحالة يكون حجم القطرة صغير ودرجة الحرارة عالية بهذا فإن القطرات تجف قبل وصولها القاعدة وتكون بشكل مسحوق تتكثف وتنتشر بشكل حبيبات ناعمة على سطح القاعدة وإن قوة التصاقها بالقاعدة يكون صغيراً جدا وبذلك يمكن از التها من القاعدة بسهولة حيث تحصل هذه الحالة عندما تكون مسافة الترسيب كبيرة.

(1-□) الخصائص التركيبية لغشاء S\_S\_S\_\_\_S\_\_ (□-1) Str \_\_ct \_\_ roperties of \_\_\_2 \_\_ S\_\_\_S\_\_ \_\_ i ....

(Ag-Chalcogenides) أحد مركبات كالكوجينايد الفضة (Ag-Chalcogenides) يعد مركب  $Ag_2ZnSnS_4$  أحد مركبات كالكوجينايد الفضة (Ag-Chalcogenides) الرباعية S, IV=Sn ,II=Zn, I=Ag وهي عناصر ارباعية I2-II-IV-VI وعند الرباعية الرباعية العامة واعدة متوفرة وغير سامة، وقد جذبت هذه المواد أهتماماً واسعا ً لتطبيقاتها المحتملة كمرشحات واعدة لأمتصاص الضوء للخلايا الشمسية [15]. يعد (AZTS) مادة متعددة التبلور من نوع (Pirquitasite) والتي تمثل الحالة المثالية من طور (Stannite) والتي لها الصيغة العامه (Pirquitasite) والتي تمثل الحالة المثالية من طور (Stannite) والتي لها الصيغة العامه (AzTS) والتي تمثل الحالة المثالية من طور (Stannite) والتي لها الصيغة العامه (AzTS) والتي التي لها الصيغة العامه (AZTS) والتي تمثل الحالة المثالية من طور (Stannite) والتي لها الصيغة العامه (Aztragonl) والتي تمثل الحالة المثالية من طور (Stannite) والتي لها الصيغة العامه (Aztragonl) والتي تمثل الحالة المثالية من طور (Stannite) والتي لها الصيغة العامه (Aztragonl) والتي تمثل الحالة المثالية من طور (Stannite) والتي لها الصيغة العامه (Aztragonl) والتي مركب (Stannite) والتي لها الصيغة العامه (Aztragonl) والتي تمثل الحالة المثالية من طور (Stannite) والتي لها الصيغة العامه (Standagonl) والتي تمثل الحالة المثالية من طور (Standagonl) والتي لها الصيغة العامه (Aztragonl) والتي التركيب الرباعي القائم (Aztragonl) وأبعاد شبيكية (Aztragonl) وأبعاد شبيكية (Aztragonl) والتي التركيب الرباعي القائم (Aztragonl) وأبعاد شبيكية والمال (Standagonl) والتي الرباعي القائم (Aztragonl) وأبعاد شبيكية (Aztragonl) والتركيب الرباعي القائم (Aztragonl) وأبعاد شبيكية (Standagonl) والشكل (I-2) ومعامل امتصاص عال (I-2) (Aztragonl) وتوصيلية من نوع (Aztragonl) والشكل (I-5) يبين وحدة بناء (Aztragonl) (Aztragonl) (I-2) يبين وحدة بناء (Aztragonl) والشكل (I-5) يبين وحدة بناء (Aztragonl) [18].



الشكل (1-5): وحدة البناء البلوري لمركب(TS□□)□ □.

يوصف (AZTS) بنوعين من التراكيب الرباعية هما (kesterite ذو المجموعة الفراغية I-4) و(Stannite ذو المجموعة الفراغية I-42m) ويمتلك كلا التركيبين ترتيبا ً ذريا ً متشابهاً. يبين الشكل (1-6) أن كلا التركيبين يتكون من مجموعة مكعبة متراصة (ccp) مرتبة من أيونات سالبة (أنيونات) مع أيونات موجبة (كاتيونات) تحتل انصاف الفراغات رباعية السطوح، إن ظهور هذه التراكيب المتشابهة بمجموعات فراغية مختلفة هو بسبب توزيعات الكاتيونات المختلفة. يتصف تركيب (Kesterite) بطبقات متعاقبة من AgZn وبالتالي فأن ذرة Ag واحدة شغلت موقع (0,0,0) مع Zn و Ag والمتبقي يترتب في المواقع (2c(0,1/2,1/4) و و (2d(0,1/2,3/4) و الناتج من المجموعة الفراغية (I-4). أما تركيب (Stannite) فيتكون من طبقات متعاقبة من ZnSn مع Ag، والناتج من المجموعه الفراغية (I-42 m) يتكون من الكاتيون ثنائي التكافؤ الموجود في نقطة الأصل 2a والكايتون أحادي التكافؤ الموجود في الموقع (0,0,1/2,1/4)، أما Sn فيقع في الموقع (2b(0,0,1/2) في كلا التركيبين [19].



الشكل (1-6): التركيب البلوري لمركب (TS□□)□□ .

## (1-9) الدراسات السابقة

#### □iter It Ire □e Ie □

نمكن الباحثون (.Ikeda et al.) سنه (2010) من تحضير سلسلة من مركبات (Co-الكالكوجيند الرباعية (AZTS وAZTS) باستعمال تقنية الترسيب المشترك (-Co الكالكوجيند الرباعية (Precipitation) بنجاح، و بينت نتائج حيود الأشعة السينية (XRD) وطيف الأشعة السينية (Tetragonal) بنجاح، و بينت نتائج حيود الأشعة السينية (ZTS) وطيف الأشعة السينية المفرقة (EDAX) أن مركبات (ZTS وZTS) تمتلك تركيب رباعي (EDAX) وبطور (EDAX)، في حين بينت نتائج الفحص البصري (EV-Vis) أن (ZTS) وبطور (e-type)، في حين بينت نتائج الفحص البصري (1.5eV) أن (VV-Vis) بمتلك حافة أمتصاص عند (R20nm) وفجوة طاقة (1.5eV) وتوصيلية من نوع (1.98eV) ، أما (AZTS) فيمتلك حافة امتصاص عند (B20nm) وفجوة طاقة (1.98eV) وذو توصيلية من نوع (n-type)، ولكلا المركبين معامل امتصاص عالي بحدود (<sup>1-104</sup>cm)، وبهذا تم الحصول على غشاء شبه موصل يعمل كطبقة امتصاص في الخلايا الشمسية [20]. حضر الباحثون (AZTS) سنه (2012) جسيمات نانوية من (AZTS) رباعية (Thermal reaction) في محلول الأوليلامين (Itermal reaction) في محلول الأوليلامين (Oleylamine) (Oleylamine) الساخن بنجاح. وقد بينت نتائج حيود الاشعة السينية (XRD) أن جسيمات (Stannite) التي تم الحصول عليها هي من نوع رباعي بطور (Stannite) ولوحظت ايضا قمم صغيرة غير محددة عند (2010, 25.5, 28.5, 28.5) والتي تدل على وجود شوائب من نوع  $Ag_8SnS_6$  وZnS. في حين بينت نتائج المحرية المحرية المحرية المحرية المحرية المحرية حين بينت نتائج المحرية المحرية المحرية المحرية المحرية على وجود شوائب من نوع محددة عند (2010) والتي تدل على وجود شوائب من نوع (AZTS) والتي تدائم محددة عند (2010) أنها تحتوي على حافة أمتصاص عند (Maction) وفجوة طاقة (2012)، في حين بين فحص هول أن (Aztra) هي مواد شبه موصله من نوع (2013).

- أنظار (AZTS) بالتعامل المعالجة الحرارية (AZTS) بأقطار (Li et al.) بأقطار حبيبية (Thermal processing) باستعمال تقنية المعالجة الحرارية (Thermal processing). و حبيبية (AZTS) باستعمال تقنية المعالجة الحرارية (AZTS) تمتلك تركيب ذا تبلور ونقاوة بينت نتائج حيود الاشعة السينية (XRD) أن جسيمات (AZTS) تمتلك تركيب ذا تبلور ونقاوة عالية من طور (Stannite) ومطابقة اللياسية (4.20%) اذ أحتوت على انماط حيود عند الزوايا (Stannite) ومطابقة اللياسية (27.4%) و المقابلة للمستويات البلورية عند الزوايا (Stannite) ومطابقة التياسية (27.4%) و المقابلة للمستويات البلورية عند الزوايا (Stannite) ومطابقة المياسية (27.4%) و المقابلة للمستويات البلورية عند الزوايا (Stannite) ومطابقة المياسية (Aztrs) و المقابلة للمستويات البلورية (Stannite) و مطابقة المنطقة القياسية (Aztrs) و المقابلة المستويات البلورية عند الزوايا (Stannite) ومطابقة المياسية (Aztrs) و المقابلة للمستويات البلورية عند الزوايا (Stannite) ومطابقة الليامية (Aztrs) و المقابلة للمستويات البلورية عند الزوايا (Stannite) ومطابقة الليامية (Aztrs) ومطابقة القياسية (Aztrs) و المقابلة للمستويات البلورية عند الزوايا (Stannite) ومطابقة الليامية القياسية (Aztrs) و المقابلة المستويات البلورية (Stannite) و عند الزوايا (Stannite) و معان (Stannite) و معان (Stannite) معاد في حين أظهرت صور المجهر (Stannite) و (Stannite) و (Stannite) و المقابي (Stannite) و المقابي و (Stannite) و المقابي (Stannite) و المقابي و (Stannite) و Stannite) معاد (Stannite) من الأليونية عبر منتظمة بتركيب رباعي (Stand (Stand



التراكيب الكروية على سطح العينات مع ملاحظة بعض الثقوب الكبيرة على سطح بعض التواكيب الكروية على سطح العينات والذي يعود الى الشوائب. في حين كشفت الفحوصات البصرية (UV-Vis) أن (AZTS) تمتلك فجوة طاقة تتراوح بين (AZTS eV) مع فجوة طاقة قليلة تابعة للشوائب Ag<sub>8</sub>SnS<sub>4</sub> تتراوح بين (1.28-1.39) [23].

- درس الباحثون (Bakr et al.) سنة (2015) تأثير درجة حراره القاعدة على الخصائص التركيبية والبصرية لأغشية (CZTS) المحضرة عن طريق عملية التحلل الكيميائي الحراري، و تم دراسة الخصائص التركيبية بواسطة فحص حيود الاشعة السينية (XRD) و أظهرت النتائج أن جميع أغشية (CZTS) ذات تركيب رباعي (ICCD 26-0575) مع أتجاه سائد ومفضل للنمو (112) ومطابقة للبطاقة القياسية (750-26 ICCD) مع وجود اطوار ثانوية، ناتجة عن زيادة الثايوريا في المحلول الذي يؤدي الى التفاعل بشكل سريع مع الايونات المعدنية المعدنية المتاحة، كما لوحظ أن حجم البلوريات يزداد مع أرتفاع درجة حرارة الطبقة السفلى. كما تم دراسة الخصائص البصرية (UV-Vis) ووجد أن فجوة الطاقة للمحضرة تتراوح بين (UV-2.5.1) [24].
- خصر الباحثون (Ma et al.) سنة (2016) غشاء رقيق من (AZTS) من المحلول المائي للمواد الأولية غير السامة والوفيرة في الارض عن طريق عملية الترذيذ بالتردد الراديوي المغناطيسي (R.F. Magntron Sputtering). وأظهرت نتائج فحوصات الاشعة السينية (XRD) والمطابقة للبطاقة القياسية (R.F. Magntron Sputtering) انماط حيود عند الزوايا (UCDD:35-0544) و (30.0 , 30.8°, 32.9°, 44.1°, 45.8°, 52.6° and 55.6°) (30.0 , 44.1°, 45.8°, 52.6° and 55.6°) (30.0 , 30.8°, 32.9°, 44.1°, 45.8°, 52.6° and 55.6°) (30.0 , 60.1) المعنويات (110) النمو. (110) (200), (201) (201) وبالأتجاه السائد(211) النمو. وتم أجراء تحليل رامان للتأكد من هوية الغشاء حيث تظهر اعلى شدة عند (<sup>1-</sup>38 cm<sup>-1</sup>) وأظهرت شدة أخرى اقل كثافة عند (<sup>1-</sup>36 cm<sup>-1</sup>) وهاتان الشدتان تكون على اتفاق مع وأظهرت شدة أخرى اقل كثافة عند (<sup>1-</sup>36 cm<sup>-1</sup>) وهاتان الشدتان تكون على اتفاق مع ودقيقاً، وبهذا فأن الأغشية المحضرة أظهرت درجة عالية من التبلور وبشكل منسق. بينما انماط فونون (AZTS). وبينت صور المجهر الإلكتروني (SEM) أن الغشاء يكون كثيفاً ودقيقاً، وبهذا فأن الأغشية المحضرة أظهرت درجة عالية من التبلور وبشكل منسق. بينما انماط فونون (AZTS). وبينت صور المجهر الإلكتروني (AZTS) في الغشاء يكون كثيفاً ودقيقاً، وبهذا فأن الأغشية المحضرة أظهرت درجة عالية من التبلور وبشكل منسق. بينما انماط فونون (AZTS). وبينت صور المجهر الإلكتروني (SEM) وماتان الغشاء يكون كثيفاً ودقيقاً، وبهذا فأن الأغشية المحضرة أظهرت درجة عالية من التبلور وبشكل منسق. بينما انماط فونون (AZTS). وبينا الغشاء يكون من نوع (AZTS). وبهذا فأن الأغشية المحضرة أظهرت درجة عالية من التبلور وبشكل منسق. بينما ودقيقاً، وبهذا فأن الأعشية المحضرة أظهرت درجة عالية من التبلور وبشكل منسق. بينما ودقيقاً، وربهذا فأن الأعشية المحضرة أظهرت درجة عالية من التبلور وبشكل منسق. بينما ودقيقاً، وربهذا فأن الأعشية المحضرة أظهرت درجة عالية من الغشاء (SER). ورمة أطرور المناق ربنا ودقيقاً، وبهذا فأن الأعشية المحضرة أظهرت درجة عالية من التبلور وبشكل منسق. من التبلور وبشكل منسق. من التبلور وبنكل منسق. من من وع (SER) ومعن الأظهرت الغرور النا معنو المحضرة أظهرت درجة والماقة براد (SEC) ورفا الغشية أغشية أعشية أخشير أوليو المو المحضرة أعشرة مورو الموور الموو الموول الموول المول



(AZTS) مادة جيدة ومنخفضة التكلفة مما يؤكد الاستعمال المحتمل في الخلايا الشمسية [25].

- ★ تمكن الباحثون (.Ma et al.) سنة (2017) من تصنيع خلية شمسية من الغشاء المتجانس (AZTS) باستعمال تقنية الترذيذ (Supttring) ومن ثم أدخال طبقات ZnS بواسطة التترذيذ بالتردد الراديوي المغناطيسي (Supttring) بنجاح. وتم تحديد الخصائص التترذيذ بالتردد الراديوي المغناطيسي (R.F. Supttring) بنجاح. وتم تحديد الخصائص التركيبية للغشاء عن طريق فحص حيود الاشعة السينية (XRD) ووجد أنها تتطابق مع البطاقة (ACD) مما يشير الى نجاح تصنيع الغشاء. في حين بينت اطياف رامان ان اوسع نطاق مهيمن يكون عند (<sup>1-</sup>338 cm<sup>-1</sup>). في حين بين الرسم المقطعي للغشاء (Cross-Section) انخفاض محتوى متا من نوع (p-type) في الاسفل وغشاء من نوع (p-type).
- درس الباحثان (Cheng and Hong) سنة (2018) تأثير محتوى Ag و Zn في الأقطاب الضوئية (AZTS) باستعمال تقنية الترذيذ المشترك (Co-Sputtring). وقد تم دراسة الخصائص التركيبية من خلال دراسة حيود الأشعة السينية (XRD) وتحليل مطياف رامان، اذ إن العينات التي تم الحصول عليها هي من طور (Stannite) ومطابقة للبطاقة وقد بينت نتائج فحص المجهر الألكتروني (SEM) أن نسبة Zn في العينات تؤثر على الشكل القياسة (LCDD:35-0544) و اظهرت جميع العينات أن المستوي (212) هو الأتجاه السائد. وقد بينت نتائج فحص المجهر الألكتروني (SEM) أن نسبة Zn في العينات تؤثر على الشكل وقد بينت نتائج فحص المجهر الألكتروني (AZTS) أن نسبة Zn في العينات تؤثر على الشكل وتر بينت نتائج فحص المجهر الألكتروني (MES) أن نسبة Zn في العينات تؤثر على الشكل وقد بينت نتائج فحص المجهر الألكتروني (MES) أن نسبة Zn في العينات تؤثر على الشكل وقد بينت نتائج فحص المجهر الألكتروني (MES) أن نسبة Zn في العينات مر وأن على الشكل وقد بينت نتائج فحص المجهر الألكتروني (MES) أن نسبة Zn في العينات تؤثر على الشكل وقد بينت نتائج فحص المجهر الألكتروني (MES) أن نسبة Zn في العينات تؤثر على الشكل وقد بينت نتائج فحص المجهر الألكتروني (MES) أن نسبة Ze في العينات تؤثر على الشكل وقد بينت نتائج فحص المجهر الألكتروني (MES) أن نسبة Ze في العينات تؤثر على الشكل وقد بينات وتركيبها و أن الحجم الحبيبي لولات (Zec مع زيادة محتوى Zec القياس ترياد مع زيادة محتوى Zec العرائي تقليص حدود الحبيات مما يزيد من قدرة الناقل على الحركة. ويادة الحجم الحبيبي يؤدي الى تقليص حدود الحبيات ما يزيد من قدرة الناقل على الحركة. وقلومت القياسات البصرية عن طريق قياس (Vec Vis) انها تمتلك حافة امتصاص عند ويادة موصل من نوع (20ev). في حين أظهرت القياسات الكهربائية من خلال تأثير هول أنه موصل من نوع (n-type) مع تركيز ناقل وتحركية ومقاومة مناسبة لتصنيع الخلايا الشمسية [27].
- ♦ قام الباحثون (AZTS) سنة (2018) بأنتاج جسيمات نانوية من (AZTS) و (CZTS)
  ♦ قام الباحثون (AZTS) سنة (Hot-Injection) مع بيان أوجه التشابه و الأختلاف بين
  (AZTS) و (CZTS). اذ تم در اسة الخصائص التركيبية عن طريق فحص حيود الاشعة

السينية (XRD) لكل من (AZTS) و(CZTS)، اذ أظهرت النتائج قمم لـ (CZTS) عند الزوايا °18.205°, 28.53°, 29.67°, 32.98°, 37.02°, 40.57°, 44.99° الزوايا (312) (302)(202)(202)(202)(202) في حين بينت أنماط حيود الأشعة والمقابلة (20~27.27°, 30.79°, 32.93°, 44.16°, 45.88°, 47.88°, 52.71° and 73.39°) والمقابلة للمستويات البلورية (240), (240), (301), (301), (200), (004), (200), (204)) في حين بينت النتائج أن الثوابت الشبيكية لكل من (AZTS) (CZTS) و a=b=0.5427 nm, c=1.0848nm و a=b=0.5427 nm, c=1.0848nm ومن خلال تحليل طيف رامان وجد ان القمم الرئيسة لـ (CZTS) عند ( 337, 337) 368 cm<sup>-1</sup>)، بينما تكون القمم الرئيسية لـ (AZTS) هي (Pirquitasite) وتكون ذات تركيب (Pirquitasite)، بينما أظهرت الخصائص البصرية للأشعه فوق البنفسجية المرئية (UV-VIS) لـ (CZTS) و (AZTS) أن (CZTS) يظهر درجة أمتصاص عالية في مدى الضوء المرئى بينما يظهر (AZTS) درجة أمتصاص تترواح بين (AZTS) وبهذا فأن فجوة الطاقة ل (AZTS) و (CZTS) هي (1.8eV) و (1.4 eV) على التوالي. في حين بينت نتائج معامل هول أن (AZTS) من نوع (n-type) و (CZTS) من نوع (p-type) وبهذا اظهرت خصائص (AZTS) كفاءه قدرها (4.51%) وهي أعلى من كفاءة الخلايا الشمسية لـ (CZTS) [28].

حضر الباحثون (Liang et al.) سنة (2018) الغشاء (AZTS) الرقيق باستعمال تقنية الترسيب الكهربائي البسيط (Simple Electron Deposition) بنجاح. تم دراسة الخصائص التركيبية بواسطة حيود الاشعة السينية (XRD) أذ أكدت أنماط الحيود للخصائص التركيبية بواسطة حيود الاشعة السينية (XRD) أذ أكدت أنماط الحيود لرعصائص التركيبية بواسطة حيود الاشعة السينية (AZTS) و المقابلة للمستويات لرعصائص التركيبية بواسطة حيود الاشعة السينية (XRD) أذ أكدت أنماط الحيود لاحصائص التركيبية بواسطة حيود الاشعة السينية (AZTS) أذ أكدت أنماط الحيود لاحصائص التركيبية بواسطة حيود الاشعة السينية (XRD) أذ أكدت أنماط الحيود لاحصائص التركيبية بواسطة حيود الاشعة السينية (AZTS) أذ أكدت أنماط الحيود لاحصائص التركيبية بواسطة حيود الاشعة السينية (AZTS) أن الخساء حيود ألائية المستويات الخسائم (AZTS) أن الغشاء (200), (201) على التوالي أن الغشاء (AZTS) يمتلك تركيباً رباعياً (Simple Electron) بنائية ونقاوة عالية. في حين أظهرت نتائج فحص المجهر الألكتروني (SEM) أن سطح (AZTS) يتألف من جسيمات كروية غير منتظمة حجمها الألكتروني (SEM) أن سطح (AZTS) يتألف من جسيمات كروية غير منتظمة حجمها الألكتروني (AZTS) أن سطح (AZTS) يتألف من جسيمات كروية غير منتظمة حجمها المولي إلى العنواني الغهرت الفحوصات البصرية أن القيمة التقديرية لفجوة الطاقة هي والي (Mathi وهي تتفق بشكل أساسي مع القيمة الفعلية (Ve 2.05) وله طيف أمتصاص واسع في المنطقة المرئية. في حين بينت الخصائص الكهربائية لشبه الموصل (AZTS) أنه



من نوع (N-type). وبهذا أظهر كفاءة عالية في الخلايا الشمسية تصل الى (%25) [29].

- ♦ قام الباحثون (Liang et al.) سنة (2018) بدر اسة مركبات الكالكوجيندات (AZTS) و(CZTS) و أثار دمج Ag على مركب (CZTS) باستعمال تقنية جديدة تعرف بأسم (Hydrothermal). وتم فحص الخصائص التركيبية لكل من (CZTS) و (AZTS) و (CAZTS) على التوالي، و أكدت نتائج أنماط حيود الأشعه السينية (XRD) لمركب (CZTS) أنه بطور (Kesterite) ومطابقة للبطاقة القياسية (ICDD:26-573)، في حين بينت النتائج لـ (AZTS) أنه بطور (Stannite) ومطابق للبطاقة القياسية (-ICDD:35 0544). وأثبتت النتائج نقاوة المركبين (AZTS) و (CZTS) من أي شوائب. في حين بينت النتائج أن أضافة Ag على مركب (CAZTS) يجعلها موصلات قابلة للتكيف من نوع (-P type) الى نوع (N-type). في حين بينت نتائج فحص المجهر الألكتروني (SEM) أن (AZTS) يتكون من جسيمات نانوية غير منتظمة يبلغ حجمها (nm 150-300 nm)، أما (CZTS) فيتكون من جسيمات نانوية غير منتظمة يبلغ حجمها (nm 50-150). بينما أظهرت الخصائص البصرية حافة أمتصاص حادة عند (nm 620 nm) وفجوة طاقة (2.05 eV) لمركب (AZTS)، في حين يمتلك (CZTS) حافة أمتصاص عند (800 nm) وفجوة طاقة (1.45eV)، وبهذا فإن مركب (CAZTS) يمتلك حافة أمتصاص عند (420nm) وغيرها من خصائص أشباه الموصلات من نوع (p-type) الى (n-type). وبهذا تم الأثبات بأنه يمكن أعتباره كمرشحات واعدة لأمتصاص الضوء للخلايا الشمسية [17] .
- ★ قام الباحثون (.khodair et al) سنة (2019) بدراسة تأثير درجة حرارة القاعدة وسمك الأغشية المحضرة على الخواص التركيبية والبصرية لأغشية (CZTS) النانوية المحضرة عن طريق عن طريق تقنية التحلل الكيميائي الحراري. حيث تم دراسة الخصائص التركيبية عن طريق فحص حيود الاشعة السينية (XRD)، إذ أظهرت النتائج أن جميع الأغشية المحضرة متعددة التبلور و ذات تركيب رباعي (Tetragonal) وأن الأتجاه السائد لجميع الأغشية هو (112) في حين كانت قيم ثوابت الشبيكة معنات التائج أن جميع الأغشية المحضرة متعددة التبلور و ذات تركيب رباعي (ICDD:25-058) وأن الأتجاه السائد لجميع الأغشية مع نتائج في حين كانت قيم ثوابت الشبيكة معالية النتائج أن معامل التشكيل (1<2) في جميع الإغشية المحضرة متعددة معنات التبلور و ذات تركيب رباعي (ICDD:25-057) وأن الأتجاه السائد لجميع المرئية (UV) البطاقة القياسية (LV) في جميع الاغشية المحضرة. وتم دراسة الخصائص البصرية للأشعه فوق البنفسجية –المرئية (-UV)، و أظهرت النتائج أن معامل التشكيل (IVS)، و أظهرت النتائج أن معامل التشكيل معامر المرئية (VIS)</p>



زيادة السمك وأظهرت قيمه معامل الأمتصاص (α>10<sup>-4</sup> cm<sup>-1</sup>) مما يشير الى أحتمال وجود عمليات انتقال مباشر في حين انخفضت قيمة فجوة الطاقة عند زيادة درجة الحرارة والسمك ووجد أن قيمة فجوة الطاقة للأغشية المحضرة (1.5eV) [30].

- حضر الباحثون (.Ag<sub>x</sub>Cu<sub>x</sub>)ZnSn(S,Se) غشاء (2019) غشاء (Dermenji et al.) الرقيق باستعمال تقنية الانحلال الحراري الكيميائي (Spray Pyrolysis). أكدت نتائج حيود الاشعة السينية (XRD) وتحليل مطياف رامان أن الغشاء الذي تم الحصول عليه من النوع الرباعي (XRD) وتحليل مطياف رامان أن الغشاء الذي تم الحصول عليه من النوع الرباعي (Tetragonal) بطور (Tetragonal). في حين أظهرت الخصائص البصرية للاشعة فوق البنفسجية –المرئية (UV-Vis) أن الغشاء الناتج يمتلك فجوة طاقة تترواح بين ( 2.1-1.1 ولاح). في حين أظهرت الخساء الناتج ويعذا أثبت فعاليته البنفسجية –المرئية (في فحص هول أن الغشاء الناتج من نوع (N-type). وبهذا أثبت فعاليته كمواد واعدة وفعاله لتطوير الخلايا الشمسية ويرجع ذلك أساساً الى العناصر الوفيرة وغير السمية [31].
- AZTS) سنة (Hu et al.) سنة (Hu et al.) من تحضير جسيمات نانوية من (AZTS) لأستخدامها كمادة أولية للأغشية الرقيقة للخلايا الشمسية باستعمال تقنية الحقن الحار (-Hot لأستخدامها كمادة أولية للأغشية الرقيقة للخلايا الشمسية باستعمال تقنية الحقن الحار (-Hot (Injection) و بينت نتائج حيود الأشعه السينية (XRD) أن (AZTS) هو من طور (Injection) و مطابقة للبطاقة القياسية (Lop=60-5734) مع بعض الشوائب مثل (Xns. (Kestrite)) ومطابقة للبطاقة القياسية (Injection) مع بعض الشوائب مثل (Xns. (Kestrite)) ومطابقة للبطاقة القياسية (Injection) مع بعض الشوائب مثل (Kestrite) ومطابقة للبطاقة القياسية (Injection) مع بعض الشوائب مثل (Xns. (Xns. (Xns.))) ومطابقة للبطاقة القياسية (Injection) مع بعض الشوائب مثل (Kestrite) ومطابقة للبطاقة القياسية (Injection) مع بعض الشوائب مثل (Injection) مع بعض الشوائب مثل (Injection) ومطابقة للبطاقة القياسية (Injection) مع بعض الشوائب مثل (Injection) مع بعض الشوائب مثل (Injection) ومطابقة القياسية (Injection) مع بعض الشوائب مثل (Injection) مع بعض الشوائب مثل (Injection) ومطابقة القياسية (Injection) مع بعض الشوائب مثل (Injection) ومطابقة القياسية (Injection) مع بعض الشوائب مثل (Injection) مع بعض الشوائب مثل (Injection) ومطابقة القياسية (Injection) مع بعض الشوائب مثل (Injection) مع بعض الشوائب مثل (Injection) ومطابقة الغهرت نتائج مطياف رامان أن أعلى قمة عند (Injection) مع بعض المتصاب حافة الخلايا الشمسية [20].
- لا تتفنية الباحثون (CZTS) بوساطة (2020) من تحضير أغشية (CZTS) بوساطة تقنية التحلل الكيميائي الحراري ودراسة الخصائص التركيبية والبصرية للأغشية المحضرة. وتم دراسة الخصائص التركيبية والبصرية للأغشية المحضرة وتم دراسة الخصائص التركيبية والسرية للأغشية المحضرة. وتم دراسة الخصائص التركيبية بواسطة حيود الأشعة السينية (XRD) ومطياف رامان إذ بينت نتائج (XRD) أن جميع الأغشية المحضرة ذات تبلور عال ومن نوع (Ictragonal) وأن الأتجاه السائد لجميع الأغشية المحضرة (112) والمطابقة للبطاقة (ICDD:26-0575) وأن الأتجاه السائد لجميع الأغشية المحضرة (112) والمطابقة للبطاقة (ICDD:26-0575) وقد لوحظ ظهور قمم ثانوية و التي تكون ناتجة عندما يكون تركيز النحاس عالياً وقد يتفاعل النحاس مع الكبريت والذي يُعد عنصراً الكترونياً ليشكل اطوار ثانوية، في حين أظهرت نتائج



مطياف رامان قمة اساسيه عند (<sup>1</sup>-330 cm) ووجدت قمم أخرى اقل شدة تكون ناتجة عن الأجهاد وعدم تجانس في توزيع الحجم، بينما أظهرت نتائج الفحص البصري (UV-Vis) أن الامتصاص العالي لجميع الأغشية يشير الى حدوث أنتقال مباشر وتتسم جميع الأغشية المحضرة بمعامل امتصاص عالي وفجوة طاقة تتراوح بين (eV 1.55-2.31) وهي قريبة جدا من فجوة الطاقة المطلوبة للمواد الماصة في الخلايا الشمسية الرقيقة [33].

#### The $\Box i \Box$ of The $\Box$ or $\Box$

(1□1) الهدف من البحث

تهدف الدراسة الحالية إلى تحضير أغشية (AZTS) الرقيقة على قواعد زجاجية وبدرجة حرارة قاعدة (20°C) بطريقة التحلل الكيميائي الحراري (Chmical Spray Pyrolysis) للحصول على أغشية بمواصفات جيدة من تجانس عال وقوة التصاق بالقاعدة وبسمك (Chmical Spray Pyrolysis)، ودراسة تأثير تركيز الثايوريا (مصدر الكبريت) على بعض خصائصها التركيبية والبصرية والكهربائية، وذلك للحصول على أغشية ذات مواصفات فيزيائية جيدة ومناسبة كطبقة ماصة في التطبيقات المستقبلية للخلايا الشمسية.